

久留米工業高等専門学校	開講年度	令和02年度(2020年度)	授業科目	集積回路工学
科目基礎情報				
科目番号	6E22	科目区分	専門 / 選択	
授業形態	講義	単位の種別と単位数	学修単位: 2	
開設学科	機械・電気システム工学専攻(電気電子工学科コース)	対象学年	専1	
開設期	後期	週時間数	2	
教科書/教材				
担当教員	村上 秀樹			
到達目標				
半導体集積回路のデバイス、プロセス、回路について、基本的な事項を理解する。				
ルーブリック				
	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	未到達レベルの目安	
先端技術も含めた集積回路の概要の理解	先端技術も含めた集積回路の概要が説明できる	半導体デバイスプロセスおよび評価技術に関して説明できる	半導体デバイス関連の基礎事項の定性的説明ができない	
評価項目2				
学科の到達目標項目との関係				
JABEE B-1				
教育方法等				
概要	バイポーラデバイス、MOSデバイス動作原理から、デバイス技術、プロセス技術、関連評価技術について講義を行う。			
授業の進め方・方法	適宜補助教材を配付しながら講義をすすめる。本科の半導体工学、半導体デバイス工学の内容を踏まえ、それらの集積回路応用に重点を置いて講義を進める。			
注意点	期末試験の成績に加え、レポートの提出状況、内容を加味し、総合的に評価する。指定した教科書のページを事前に読んでおくこと			
授業計画				
	週	授業内容	週ごとの到達目標	
後期	3rdQ	1週	pn接合デバイスの動作原理	
		2週	バイポーラトランジスタの動作原理	
		3週	M/S接合の基礎事項	
		4週	接合デバイス形成プロセスの概要と先端技術の紹介	
		5週	MOSダイオードの動作原理	
		6週	MOSトランジスタの動作原理	
		7週	MOSトランジスタの形成プロセスの概要	
		8週	MOSトランジスタの形成プロセスの各論	
	4thQ	9週	先端プロセス技術の紹介	
		10週	フロントエンドプロセスの概要	
		11週	バックエンドプロセスの概要	
		12週	半導体関連物性評価技術	
		13週	半導体関連物性評価技術	
		14週	集積回路技術	
		15週	集積回路技術	
		16週		

#### モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標

分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週
専門的能力	分野別の専門工学 電気・電子系分野	電子工学	電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。	3	後1
			エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。	3	後1
			原子の構造を説明できる。	3	後1
			パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。	3	後1
			結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。	3	後1
			金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。	3	後3
			真性半導体と不純物半導体を説明できる。	3	後2
			半導体のエネルギーバンド図を説明できる。	3	後2
			pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流-電圧特性を説明できる。	3	後2,後4
			バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。	3	後2,後4
電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。				3	後5,後6,後7

#### 評価割合

	試験	発表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	0	0	0	0	90	10	100

基礎的能力	0	0	0	0	30	5	35
専門的能力	0	0	0	0	45	5	50
分野横断的能力	0	0	0	0	15	0	15